

ISSN 1004-3365
CN 50-1090/TN
CODEN:WEIDFK



Q K 2 2 1 2 4 0 6

微电子学

MICROELECTRONICS

中文核心期刊

2022
第 52 卷 1

四川固体电路研究所 主办
模拟集成电路国家级重点实验室 协办



ISSN 1004-3365



9 771004 336228



《微电子学》微信公众号

微电子学

Weidianzixue

第 52 卷 第 1 期 2022 年 2 月

目 次

· 电路与系统设计 ·

- 一种高效率 Buck 变换器的设计 刘俊宏, 罗 萍, 赵 忠, 杨秉中, 曹 麟(1)
高速流水线结构的大整数乘法器 FPGA 设计与实现 涂振兴, 王晓蕾, 杜高明, 李桢昊(6)
一种低压低功耗伪差分环形压控振荡器的设计 龙仁伟, 冯全源(12)
低功耗非对称性可调 STDP 突触电路设计 王 巍, 张 珊, 赵汝法, 张定冬, 熊德宇, 袁 军(17)
一种性能多种重构的高频压控有源电感 李 白, 张万荣, 谢红云, 金冬月, 那伟聪, 李祎康, 康翼麟(22)
一种 S 波段 E 类 GaN HEMT 功率放大器设计 王德勇, 张盼盼, 张金灿, 刘 敏, 刘 博, 孙立功(28)
多晶硅电阻线性度补偿方法研究 杨 洋, 雷郎成, 高炜祺, 胡永菲, 刘虹宏, 付东兵(33)
一种杂波中提取弱小脉冲信号的设计方法 李伟东, 刘登学, 庞佑兵(38)
一种延迟可控的异步 FIFO 电路设计 陈婷婷, 陆 锋, 万书芹, 邵 杰(42)
一种面向存算的高速字线驱动电路 王雨桐, 虞致国, 车 饶, 顾晓峰(47)
56 Gbit/s PAM4 CMOS 光接收机前端电路设计 张 宇, 张长春, 姚俊杰, 袁 丰(52)
一种 36 GHz CMOS 毫米波三倍频器 赵心可, 徐雷钧, 白 雪(58)
一种基于 FPGA 进位逻辑的 RO PUF 设计 陈 鹏, 李先东, 姚 亮, 易茂祥, 鲁迎春(65)

· 动态与综述 ·

- 基于石墨烯的 CO 和 CO₂ 气体传感器研究进展 张适然, 唐 蒙, 邓丽城, 王德波(71)

· 半导体器件与工艺 ·

- 一种用于高压防护的新型闩锁免疫 LDMOS 孙浩楠, 王军超, 李浩亮, 张英韬(77)
基于多层石墨烯的声表面波放大器的研究 何素荣, 赵 程, 李晨媛, 邓丽城, 王德波(82)
一种高维持电压的 LVTSCR 陈 龙, 李健儿, 廖 楠, 徐银森, 冯 勇, 刘继芝, 徐开凯, 赵建明(87)
一种防闩锁的多嵌入阱 SCR ESD 器件 侯佳力, 胡 毅, 贺俊敏, 王 源(91)
L 波段双层交指线性相位 MEMS 滤波器的设计 范丽娜, 吴倩楠, 张世义, 侯 文, 李孟委(98)
一种低触发电压的两级防护 SCR 器件
..... 张英韬, 朱治华, 范晓梅, 毛 盼, 宋 彬, 许杞安, 吴铁将, 陈睿科, 王 耀, 刘俊杰(104)
界面电荷对圆柱形高 k VDMOS 的影响仿真研究 刘 乙(109)
基于 COMSOL 的 TSV 电感多物理场耦合特性研究 尹湘坤, 刘景亭, 王凤娟(115)
应用于 5 V 电压电路的新型闩锁免疫 LVTSCR 王松岩, 范晓梅, 朱治华, 张英韬, 王 耀, 刘俊杰, 陈睿科(120)
SiC/GaN IMPATT 二极管的交流性能研究
..... 戴 扬, 叶青松, 党江涛, 卢昭阳, 张为伟, 雷晓艺, 张云尧, 廖晨光, 赵胜雷, 赵 武(125)
栅下双异质结增强型 AlGaN/GaN HEMT 陈 飞, 冯全源, 杨红锦, 文 庚(132)

· 产品与可靠性 ·

- 源端射频干扰下 SRAM 的抗扰性分析 徐小清, 张志文, 粟 涛(139)
基于正交法的 FBGA 焊点可靠性优化研究 孙勤润, 杨雪霞, 张伟伟, 王 超, 刘昭云, 彭银飞(144)
Flash 存储器浮栅单元的总剂量效应统计性分析 梁润成, 陈法国, 郭 荣, 韩 毅, 刘兆行, 张 静, 赵 日(150)

Microelectronics

Vol. 52, No. 1 Feb. 2022

Contents

• Circuit and System Design •

Design of a High Efficiency Buck Converter	LIU Junhong, LUO Ping, ZHAO Zhong, et al(1)
FPGA Design and Implementation of a Large Integer Multiplier with High Speed Pipeline Structure	TU Zhenxing, WANG Xiaolei, DU Gaoming, et al(6)
Design of a Low-Voltage Low-Power Pseudo-Differential Ring VCO	LONG Renwei, FENG Quanyuan(12)
Design of a Low Power Asymmetrically Tunable STDP Synapse Circuit	WANG Wei, ZHANG Shan, CHIOU U-Fat, et al(17)
A High Frequency Voltage Controlled Active Inductor with Multiple Reconfigurable Performances	LI Bai, ZHANG Wanrong, XIE Hongyun, et al(22)
Design of a S-Band Class-E GaN HEMT Power Amplifier	WANG Deyong, ZHANG Panpan, ZHANG Jincan, et al(28)
Study on Compensation Method for Polysilicon Resistance Linearity	YANG Yang, LEI Langcheng, GAO Weiqi, et al(33)
A Design Method for Extracting Weak Pulse Signal from Clutter	LI Weidong, LIU Dengxue, PANG Youbing(38)
Design of a Controllable Delay Asynchronous FIFO Circuit	CHEN Tingting, LU Feng, WAN Shuqin, et al(42)
A High Speed Word Line Drive Circuit for Compute-in-Memory	WANG Yutong, YU Zhiguo, CHE Rao, et al(47)
Design of a 56 Gbit/s PAM4 CMOS Optical Receiver Front-End	ZHANG Yu, ZHANG Changchun, YAO Junjie, et al(52)
A 36 GHz CMOS Millimeter-Wave Frequency Tripler	ZHAO Xinke, XU Leijun, BAI Xue(58)
Design of a RO PUF Based on FPGA Carry Logic	CHEN Peng, LI Xiandong, YAO Liang, et al(65)

• Features and Review •

Research Progress of CO and CO ₂ Gas Sensors Based on Graphene	ZHANG Shiran, TANG Meng, DENG Licheng, et al(71)
---	--

• Semiconductor Device and Technology •

A Novel Latch-Immune LDMOS for High-Voltage Protection	SUN Haonan, WANG Junchao, LI Haoliang, et al(77)
Research on a Surface Acoustic Wave Amplifier Based on Multilayer Graphene	HE Surong, ZHAO Cheng, LI Chenyuan, et al(82)
A LVTSCR with High Holding Voltage	CHEN Long, LI Jian'er, MIAO Nan, et al(87)
A Latch-Up Immunity Multi-Embedded-Well SCR ESD Device	HOU Jiali, HU Yi, HE Junmin, et al(91)
Design of a L-Band Double-Layer Interdigital Linear Phase MEMS Filter	FAN Lina, WU Qiannan, ZHANG Shiyi, et al(98)
A Two-Stage-Protection SCR Device with Low Trigger Voltage	ZHANG Yingtao, ZHU Zhihua, FAN Xiaomei, et al(104)
Simulation Study on the Effect of Interface Charge on Cylindrical High k VDMOS	LIU Yi(109)
COMSOL-Based Multi-Physical Field Coupling Characteristics for TSV Inductors	YIN Xiangkun, LIU Jingting, WANG Fengjuan(115)
A Novel Latch-Up-Immune LVTSCR for 5 V Operating Voltage Circuit	WANG Songyan, FAN Xiaomei, ZHU Zhihua, et al(120)
Study on RF Performance of SiC/GaN IMPATT Diode	DAI Yang, YE Qingsong, DANG Jiangtao, et al(125)
An Enhancement-Mode AlGaN/GaN HEMT with Double Heterojunction Under Gate	CHEN Fei, FENG Quanyuan, YANG Hongjin, et al(132)

• Product and Reliability •

Immunity Analysis of SRAM Under Supply RF Interference	XU Xiaoqing, ZHANG Zhiwen, SU Tao(139)
Research on Optimal FBGA Solder Joints Reliability Based on Orthogonal Method	SUN Qinrun, YANG Xuexia, ZHANG Weiwei, et al(144)
Statistical Analysis of Total Ionizing Dose Effect on Flash Memory Floating Gate Cells	LIANG Runcheng, CHEN Faguo, GUO Rong, et al(150)

《微电子学》第八届编辑委员会

顾问 王阳元(科学院院士) 许居衍(工程院院士)
吴德馨(科学院院士) 郝跃(科学院院士)
刘明(科学院院士) 叶甜春 魏少军 徐世六 胡刚毅
主任 王涛
副主任 徐学良
委员(以姓氏笔画为序)

万天才 马 瑶 尹勇生 毛志刚 王友华 王国兴 王宗民
王 源 付晓君 乔 明 刘冬生 刘 璜 孙 楠 朱坤峰
江建慧 严利人 吴传贵 张万里 张万荣 张正元 张 兴
张红升 张国和 张 波 张培健 张 鸿 时龙兴 李文昌
李志强 李 婷 李 强 李 斌 李儒章 杨华中 杨 虹
肖知明 苏永波 陈 智 陈 雷 罗 萍 姜汉钧 胡盛东
胡辉勇 唐 枫 唐昭焕 唐 鹤 徐开凯 徐代果 徐 申
徐佳伟 袁宝山 曹中复 黄 杰 储 涛 韩建伟 韩郑生
韩 磊 蒲 颜 廖希异 廖建军 廖鹏飞

微电子学 Weidianzixue

(双月刊)(1971年创刊)
第52卷 第1期(总第297期)
2022年2月20日出版

Microelectronics
(Bimonthly)(Started in 1971)
Vol. 52, No. 1 (Serial Issue No. 297)
Published on Feb. 20, 2022

主 管:中国电子科技集团公司
主 办:四川固体电路研究所
协 办:模拟集成电路国家级重点实验室

Responsible Institution: China Electronics Technology Group Corp.
Sponsored by: Sichuan Institute of Solid-State Circuits
Co-organized by: National Laboratory of Science and Technology on Analog Integrated Circuit

编 辑 出 版:《微电子学》编辑部
(400060 重庆南坪花园路14号24所)
电 话:86-23-62834360
电子邮箱:wdzx@sisc.com.cn
wdzx128@sina.com

Edited & Published by: Editorial Department of *Microelectronics*
(400060, Sichuan Institute of Solid-State Circuits, Nanping, Chongqing)
Tel: 86-23-62834360
E-mail: wdzx@sisc.com.cn
wdzx128@sina.com
Website: <http://www.microelec.cn>

编委会主任:王 涛
主 编:付晓君
执行主编:武俊齐
印 刷:重庆市国丰印务有限责任公司
发 行:《微电子学》编辑部

Director of Editorial Board: WANG Tao
Editor-in-Chief: FU Xiaojun
Executive Chief Editor: WU Junqi
Printed by: Chongqing Guofeng Printing Company Ltd.
Distributed by: Editorial Department of *Microelectronics*

发行范围:国内外公开发行

国际标准连续出版物号:ISSN 1004-3365
国内统一连续出版物号:CN 50-1090/TN

国内定价:30.00元